

ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GaAs

Лёгкая много переходная технология | AM1.5G

Стандартный чип	40 × 20 mm
Микроэнергетический чип	10 × 10 mm
Толщина	<30 µm
Поверхностная плотность	200 g/m²
Фотоэлектрический КПД	>34%
Pmax	270 mW / 33 mW
Voc / Vmp	3.0 V / 2.7 V
Isc / Imp	103 / 100 mA; 12.6 / 12.3 mA

Engineering note / Инженерное примечание

Параметры относятся к предоставленному материалу. Размер, электрическая конфигурация, радиус изгиба и упаковка требуют подтверждения проекта.